









	<h2>STP18NM60ND</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STP18NM60ND</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 13A TO-220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STP18NM60ND.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32400 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STP18NM60ND</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 13A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32400 pcs Stock
Serie	FDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1030pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STP18NM60ND ist neu im Original, Suche STP18NM60ND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP18NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STP18NM60ND: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP18NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-220</p>	 <p><b>STP18N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V TO-220</p>	 <p><b>STP18NM80</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 17A TO-220</p>	 <p><b>STP18N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15A TO-220</p>
 <p><b>STP19N06L</b> ST STP19N06L ST</p>	 <p><b>STP18P06P</b> ST STP18P06P ST</p>	 <p><b>STP18N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 12A</p>	 <p><b>STP190NF04</b> ST STP190NF04 ST</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STP16N10L	↔ STP16N65M5	⇒ STP16NE06	D STP16NE06L	⇒ STP16NF06
⊣ STP16NF06FP	⊗ STP16NF06L	D STP16NF25	⇒ STP16NK60Z	⇒ STP16NS25
⊗ STP17N25	⊣ STP17NF25	⊗ STP17NK40ZFP	↔ STP180N10F3	⇒ STP180N55
D STP180N55F3	⊗ STP180NS04ZC	⊣ STP185N10F3	⊗ STP185N55	⇒ STP185N55F3
⇒ STP18N06	↔ STP18N55M5	⊗ STP18N60M2	⊣ STP18N65M5	⇒ STP18NM60N
↔ STP18NM80	⇒ STP18P06P	D STP190N55LF3	⊗ STP190NF04	⊣ STP19NB20
⊗ STP19NB20FP	D STP19NF20	⇒ STP2002QFP	↔ STP2003QFP	⇒ STP200NF03
⊣ STP200NF04	⊗ STP200NF04L	↔ STP20N10L	⇒ STP20N20	⇒ STP20N60
⊗ STP20NE06L	⊣ STP20NF06	⊗ STP20NF06L	D STP20NF20	⇒ STP20NK50Z
↔ STP20NM50	⊗ STP20NM50FP	⊣ STP20NM60	⊗ STP20NM60FD	⇒ STP20NM60FP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited